## GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器, 10 - 40 GHz

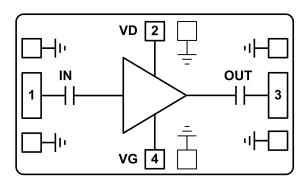
## 主要特点

工作频率: 10 - 40 GHz

噪声系数: 4 dB 增益: 7.5 dB P1dB: +13 dBm

自偏置供电: +3 V @ 40 mA 输入/输出: 50 Ohm 匹配 芯片尺寸: 1.3×1×0.1 mm<sup>3</sup>

### 功能框图

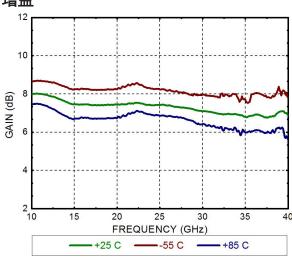


性能指标 (T<sub>A</sub> = +25°C, VDD = +3 V,IDD = 40 mA\*)

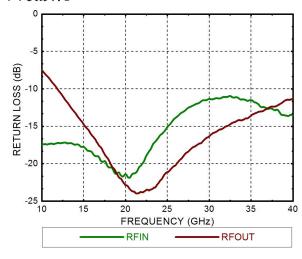
| 参数           | 最小    | 典型   | 最大 | 最小      | 典型   | 最大 | 最小    | 典型   | 最大 | 单位  |
|--------------|-------|------|----|---------|------|----|-------|------|----|-----|
| 频率范围         | 10-20 |      |    | 20 - 30 |      |    | 30-40 |      |    | GHz |
| 增益           |       | 7.7  |    |         | 7.2  |    |       | 7    |    | dB  |
| 增益平坦度        |       | ±0.3 |    |         | ±0.2 |    |       | ±0.3 |    | dB  |
| 输入回波损耗       |       | 18   |    |         | 15   |    |       | 12   |    | dB  |
| 输出回波损耗       |       | 10   |    |         | 15   |    |       | 12   |    | dB  |
| 输出功率 1dB 压缩点 |       | 14   |    |         | 14   |    |       | 13   |    | dBm |
| 饱和功率         |       | 16.5 |    |         | 16.5 |    |       | 15.5 |    | dBm |
| 输出 IP3       |       | 23   |    |         | 23   |    |       | 22   |    | dBm |
| 噪声系数         |       | 4.7  |    |         | 4    |    |       | 4.2  |    | dB  |
| 工作电流         |       | 40   |    |         | 40   |    |       | 40   |    | mA  |

<sup>\*</sup>备注:可以通过调整 VG 电压来控制工作电流, VG 调节范围: -0.6 ~ 0V。

# 増益

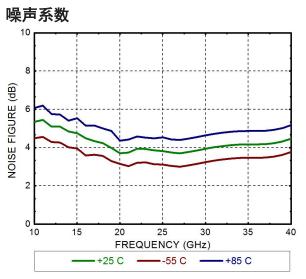


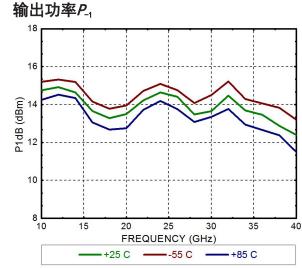
## 回波损耗



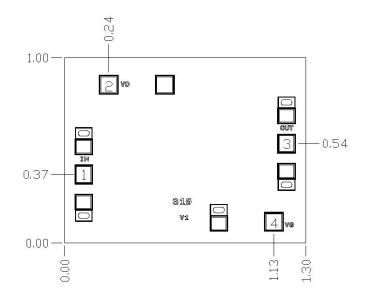


## GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器,10 - 40 GHz





## 物理参数



### 焊盘描述

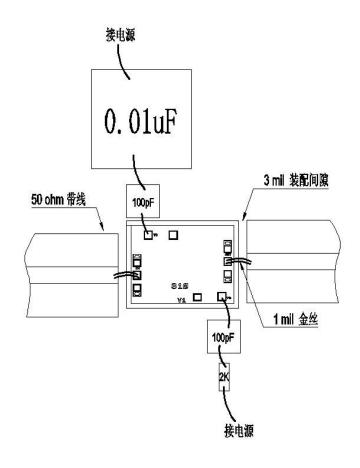
| 焊盘序号 | 功能  | 描述                                     |  |  |  |
|------|-----|--|--|--|--|
| 1    | IN  | 该焊盘是 AC 耦合,并匹配至 50 Ohm                 |  |  |  |
| 2    | VD  | 该焊盘提供放大器的电源电压,需要外接 100pF 和 0.01µF 旁路电容 |  |  |  |
| 3    | OUT | 该焊盘是 AC 耦合,并匹配至 50 Ohm                 |  |  |  |
| 4    | VG  | 该焊盘提供放大器的栅极控制电压,需要外接 100pF 旁路电容        |  |  |  |
| 芯片背面 | GND | 芯片背面必须连接至 RF/DC 地                      |  |  |  |

成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室 电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597



GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器,10 - 40 GHz

### 装配图



#### 注意事项

- 1. 芯片厚度为 100 um
- 2. 典型键合焊盘尺寸为 100\*100 um<sup>2</sup>
- 3. 键合焊盘金属化: 金
- 4. 芯片背面镀金
- 5. 芯片背面接地
- 6. 未标注的键合焊盘不需要连接
- 7. 本产品采用空气桥工艺,表面不带钝化层

#### 极限参数

- 1. 电源电压: +5 V
- 2. 射频输入功率: +18 dBm
- 3. 储存温度: -65~+175°C
- 4. 工作温度: -55~+85°C